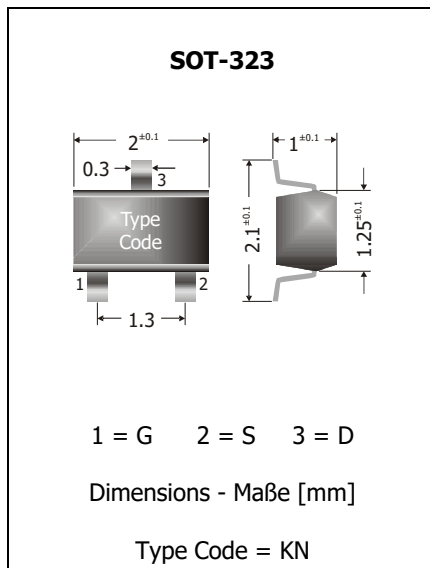


MMFTN3018W
N-Channel Enhancement Mode FET
N-Kanal FET – Anreicherungstyp

I_D	= 100 mA	V_{DSS}	= 60 V
$R_{DS(on)1}$	< 8 Ω	P_{tot}	= 200 mW
T_{jmax}	= 150°C		

Version 2017-06-26

**Typical Applications**

Signal processing, Drivers,
 Logic level converter
 Commercial grade ¹⁾

Features

Fast switching times
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled	3000 / 7 ⁿ
Weight approx.	0.01 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL = 1

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung, Treiberstufen,
 Logikpegelwandler
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Schnelle Schaltzeiten
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

		MMFTN3018W	
Drain-Source-voltage – Drain-Source-Spannung	V_{DS}	60 V	
Gate-Source-voltage – Gate-Source-Spannung	V_{GS}	D open	± 20 V
Power dissipation – Verlustleistung	P_{tot}	200 mW	
Drain current – Drainstrom	I_D	dc	100 mA
Peak Drain current – Drain-Spitzenstrom	I_{DM}	400 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	-55...+150°C	

Characteristics**Kennwerte**

		$T_j = 25^\circ\text{C}$		
		Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung	$V_{(BR)DSS}$	30 V	–	–
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom	I_{DSS}	–	–	1 μA
Gate-Source leakage current – Gate-Source Leckstrom	$\pm I_{GSS}$	–	–	1 μA
Gate-Source threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung	$V_{GS(th)}$	0.8 V	–	1.5 V

¹ Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

² $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben

Characteristics
Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand					
$V_{GS} = 4\text{ V}, I_D = 10\text{ mA}$	$R_{DS(on)}$		–	–	8 Ω
$V_{GS} = 2.5\text{ V}, I_D = 1\text{ mA}$					13 Ω
Forward Transfer Admittance – Übertragungssteilheit					
$V_{DS} = 3\text{ V}, I_D = 10\text{ mA}$	g_{FS}		20 mS	–	–
Input Capacitance – Eingangskapazität					
$V_{DS} = 5\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{iss}		–	13 pF	–
Output Capacitance – Ausgangskapazität					
$V_{DS} = 5\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{oss}		–	9 pF	–
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität					
$V_{DS} = 5\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{rss}		–	4 pF	–
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R_{thA}	< 625 K/W ¹⁾		

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Diotec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [D2003UK](#) [705463DB](#) [MCH6422-TL-E](#) [FW231A-TL-E](#) [APT5010JFLL](#) [NTNS3A92PZT5G](#) [IRF100S201](#) [JANTX2N5237](#)
[2SK2464-TL-E](#) [2SK3818-DL-E](#) [FCA20N60_F109](#) [FDZ595PZ](#) [STD6600NT4G](#) [FQD4P40TM_AM002](#) [FSS804-TL-E](#) [FW217A-TL-2W](#)
[APT10050JVFR](#) [2SJ277-DL-E](#) [2SK1691-DL-E](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [D1014UK](#) [D2294UK](#) [405094E](#) [423220D](#) [MCH6646-TL-E](#) [TPCC8103,L1Q\(CM](#)
[IRF3710](#) [367-8430-0972-503](#) [VN1206L](#) [424134F](#) [026935X](#) [051075F](#) [SBVS138LT1G](#) [614234A](#) [715780A](#) [NTNS3166NZT5G](#) [751625C](#) [873612G](#)
[IPS70R2K0CEAKMA1](#) [APT8015JVFR](#) [APT50M85JVR](#) [APT5010JVFR](#) [APT12031JFLL](#) [APT12040JVR](#) [NTE6400](#) [NVC3S5A51PLZT1G](#)
[JANTX2N6796U](#) [JANTX2N6784U](#)